

2N3494
2N3495

**SILICON
PNP TRANSISTORS**



TO-39 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N3494 and 2N3495 are silicon PNP transistors designed for general purpose amplifier and switching applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Collector-Base Voltage
Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Power Dissipation
Power Dissipation ($T_C=25^\circ\text{C}$)
Operating and Storage Junction Temperature

SYMBOL	2N3494	2N3495	UNITS
V_{CBO}	80	120	V
V_{CEO}	80	120	V
V_{EBO}		4.5	V
I_C		100	mA
P_D		0.6	W
P_D		3.0	W
T_J, T_{stg}		-65 to +200	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

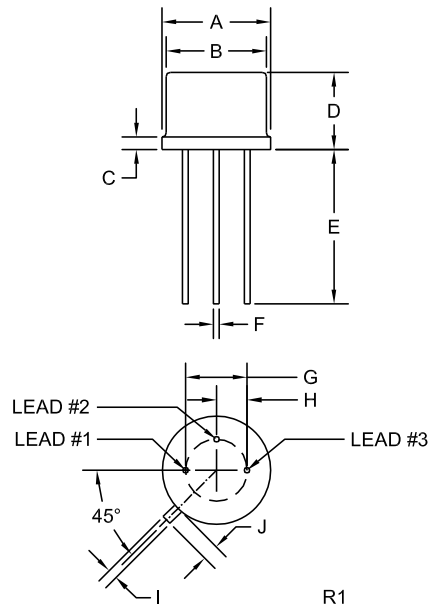
SYMBOL	TEST CONDITIONS	2N3494		2N3495		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V}$ (2N3494)	-	100	-	-	nA
I_{CBO}	$V_{CB}=90\text{V}$ (2N3495)	-	-	-	100	nA
I_{EBO}	$V_{EB}=3.0\text{V}$	-	25	-	25	nA
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$	80	-	120	-	V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	80	-	120	-	V
BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	4.5	-	4.5	-	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	-	0.3	-	0.35	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	0.6	0.9	0.6	0.9	V
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=100\mu\text{A}$	35	-	35	-	
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$	40	-	40	-	
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}$	40	-	40	-	
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	40	-	40	-	
h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=100\text{mA}$	35	-	-	-	
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=20\text{mA}, f=100\text{MHz}$	200	-	150	-	MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=100\text{kHz}$	-	7.0	-	6.0	pF
C_{ib}	$V_{EB}=2.0\text{V}, I_C=0, f=100\text{kHz}$	-	30	-	30	pF
h_{ie}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	0.1	1.2	0.1	1.2	k Ω
h_{re}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	-	2.0	-	2.0	$\times 10^{-4}$
h_{fe}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	40	300	40	300	
h_{oe}	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	-	300	-	300	μS
$Re(h_{ie})$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=20\text{mA}, f=300\text{MHz}$	-	30	-	30	Ω
t_{on}	$V_{CC}=30\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=1.0\text{mA}$	-	300	-	300	ns
t_{off}	$V_{CC}=30\text{V}, I_C=10\text{mA}, I_{B1}=I_{B2}=1.0\text{mA}$	-	1.0	-	1.0	ms

R0 (11-March 2015)

2N3494
 2N3495
 SILICON
 PNP TRANSISTORS



TO-39 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A (DIA)	0.335	0.370	8.51	9.40
B (DIA)	0.315	0.335	8.00	8.51
C	-	0.040	-	1.02
D	0.240	0.260	6.10	6.60
E	0.500	-	12.70	-
F (DIA)	0.016	0.021	0.41	0.53
G (DIA)	0.200		5.08	
H	0.100		2.54	
I	0.028	0.034	0.71	0.86
J	0.029	0.045	0.74	1.14

TO-39 (REV: R1)

LEAD CODE:

- 1) Emitter
- 2) Base
- 3) Collector

MARKING: FULL PART NUMBER

R0 (11-March 2015)

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9